



主要特点

- 较低的启动电流 (大约3μA)
- 全电压范围待机低于75mW
- 满足六级能效标准
- 内置软启动减少MOSFET应力
- 内建同步斜坡补偿, 消除次谐波振荡
- 内建频率抖动功能, 降低EMI
- 内置65kHz开关频率
- 轻载降低工作频率
- VDD宽工作范围
- VDD过压保护功能
- 内置前沿消隐电路
- 逐周期过流保护
- 内置过温保护
- 过载保护
- DIP-8L绿色封装

基本应用

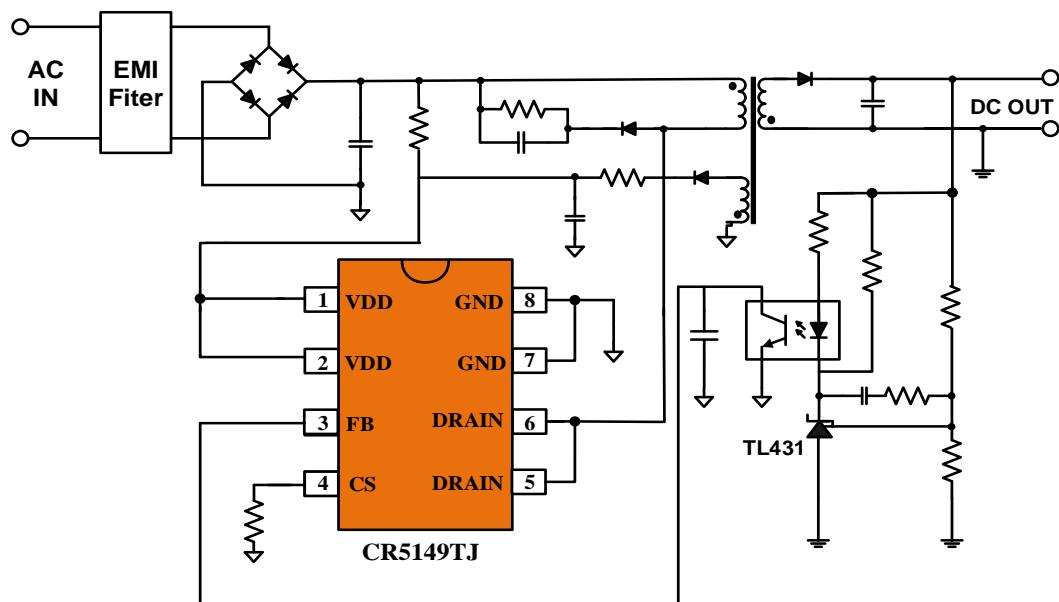
- 电源适配器
- 机顶盒电源
- 充电器
- 存储设备电源

产品概述

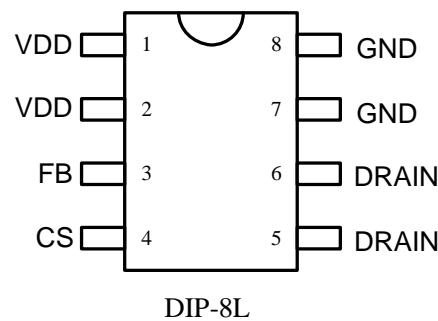
CR5149TJ 是一款高集成度、低待机功耗的 CCM+PFM 混合电流模式 PWM 控制开关。CR5149TJ 轻载时会降低频率，最低频率 22kHz 可避免音频噪声。CR5149TJ 提供了完整的保护功能，如 OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO 等。软启动功

能可以减少系统启动时 MOSFET 的应力，前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计，降低开关噪声，简化了 EMI 设计。CR5149TJ 提供 DIP-8L 的封装。

典型应用



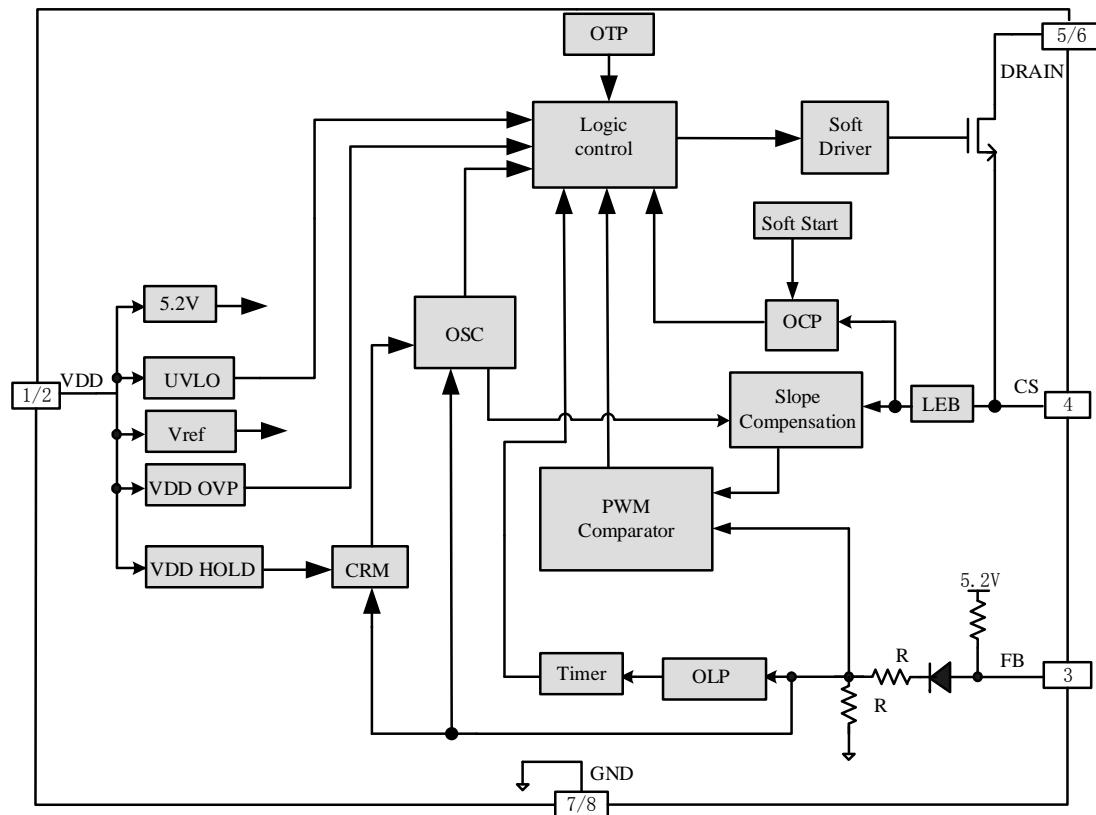
管脚排列



管脚描述

引脚序号	符号	描述
1/2	VDD	电源脚
3	FB	电压反馈脚, 和 CS 共同决定输出占空比, 同时此脚控制系统工作频率
4	CS	电流检测脚, 连接电阻在 MOSFET 的源和地之间检测电感电流
5/6	DRAIN	HV MOSFET 漏端引脚
7/8	GND	地脚

结构框图





极限参数

符号	描述		值	单位
V _{VDD}	电源电压		-0.3~38	V
V _{FB}	FB脚输入电压		-0.3~7	V
V _{CS}	CS脚输入电压		-0.3~7	V
T _L	焊接温度	10s	260	°C
T _J	工作结温范围		-40 ~150	°C
ESD	人体模式 HBM		2k	V
T _{stg}	存储温度		-55 ~150	°C

推荐工作环境

型号	封装	90-264VAC
		适配器 ¹
CR5149TJ	DIP-8L	≤18W

1. 适配器应用实际最大功率必须保证足够的 DRAIN 散热面积, 测试条件 40°C 环境温度。增加散热面积或风冷来减小热阻可以获得更高的输出功率。

电气参数

(T_A=25 °C 除非特别说明 VDD = 18V)

符号	参数描述	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源部分 (VDD Pin)						
I _{ST}	启动电流	UVLO _{OFF} =1V	3.0	10.0	10.0	μA
I _{OP}	工作电流	V _{CS} =0V, V _{FB} =3V	2.5	3.5	3.5	mA
I _{OP_CRM}	CRM 模式工作电流	V _{CS} =0V, V _{FB} =0.5V	0.6	0.7	0.7	mA
UVLO _{OFF}	系统启动 VDD 电压		16.5	17.5	18.5	V
UVLO _{ON}	系统关断 VDD 电压		8	8.5	9	V
VDD _{OVP}	VDD 过压保护		35	36.5	38	V
反馈部分(FB Pin)						
A _{VCS}	PWM 输入增益 Δ FB/ Δ CS		3.5			V/V
I _{FB}	FB 短路电流	V _{FB} =0V	220			μA
V _{FB}	FB 开路电压	V _{FB} =Open	5.2			V
D _{MAX}	最大占空比		77	80	83	%
V _{REF_GREEN}	进入 PFM 时的 FB 电压		2.1			V
V _{CRM_H}	退出 CRM 时的 FB 电压		1.3			V
V _{CRM_L}	进入 CRM 时的 FB 电压		1.2			V
V _{OLP}	过载保护时 FB 电压		4.4			V
T _{O LP}	过载保护延迟时间		60			ms
电流检测部分 (CS Pin)						
T _{SS}	软启动时间		2.5			ms
T _{LEB}	前沿消隐时间		300			ns
T _{D_OC}	过流检测延迟时间		90			ns
V _{TH_OC}	零占空比时过流检测阈值电压	0.43	0.45	0.47		V
V _{TH_OC_CLAMP}	过流检测箝位电压		0.72			V
内部热保护						
OTP	过热保护检测的温度		150			°C
Hys.	过热保护检测迟滞		30			°C
功率 MOSFET						
BV _{dss}	MOSFET 漏源击穿电压	V _{GS} =0V, I _{DS} =250μA	650			V
R _{DS_ON}	漏源之间静态导通电阻	CR5149TJ	V _{GS} =10V, I _{DS} =2A	2.3		ohm
振荡器部分						
F _{osc}	PWM 频率		60	65	70	kHz



CR5149TJ

高性能CCM+PFM绿色节能PWM控制开关

F_{PFM}	PFM 最小频率			22		kHz
ΔF_{VDD}	VDD 对 PWM 频率的影响			1		%
ΔF_{TEMP}	温度对 PWM 频率的影响	-30°C~100°C		1		%
ΔF_{JITTER}	频率抖动范围		-6		6	%
F_{JITTER}	频率抖动周期			32		Hz

芯片概述

CR5149TJ 是一款高集成度、低待机功耗的电流模式 PWM 控制开关。CR5149TJ 轻载时会降低频率，最低频率 22kHz 可避免音频噪声，系统采用 CCM+PFM 混合控制模式以减小系统损耗，达到绿色节能的目的。IC 集成了丰富的保护功能，简化了电路系统应用设计。

绿色节能

CR5149TJ 为多模式 PWM 控制器，在重载时工作在 PWM 模式，频率为 65kHz，通过调节脉冲宽度控制输出电压。FB 电压随着负载减小而减小，当 FB 电压小于设定电压值 V_{REF_GREEN} 时，内部模式控制器进入 PFM，振荡器的工作频率随着负载的降低而降低，并最终钳位在 22kHz 附近，当 FB 电压继续减小时，内部模式控制器进入 CRM 模式，进一步降低待机功耗。

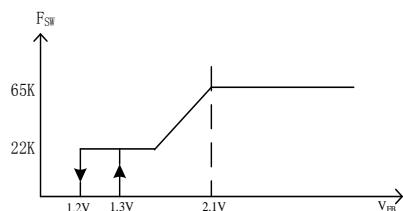


图 1 系统工作频率与 FB 电压示意图

内部同步斜坡补偿

电流模式控制比普通的电压模式控制具有很多优点，但是同样存在着一些缺点。特别是当 PWM 占空比大于 50%，整个控制环路可能变得不稳定，抗干扰性能变差。CR5149TJ 内置一个同步的斜坡补偿可以提高系统的稳定性，防止电压毛刺产生的次谐波振荡。

软启动

VDD 电源启动瞬间，CR5149TJ 芯片内部都将触发软启动功能，即在 VDD 电压达到 UVLO_{OFF} 以后，在大约 2.5ms 时间内，峰值电流从 0 上升到最大值峰值电流，以减少电源启动期间功率管电压应力。

前沿消隐 (LEB)

开关管的每次开启不可避免带来开关毛刺，它通过 R_{CS} 采样后，对内部逻辑电路带来干扰，引起内部寄存器的误动作。CR5149TJ 中设计了 300ns 的前沿消隐电路，它可以代替传统的外接 RC 滤波电路，简化外围设计。

功率输出

CR5149TJ 采用特殊的驱动输出，采用软驱动模式，降低功率 MOSFET 开关噪声，同时减小了功率 MOSFET 开关损耗。

保护功能

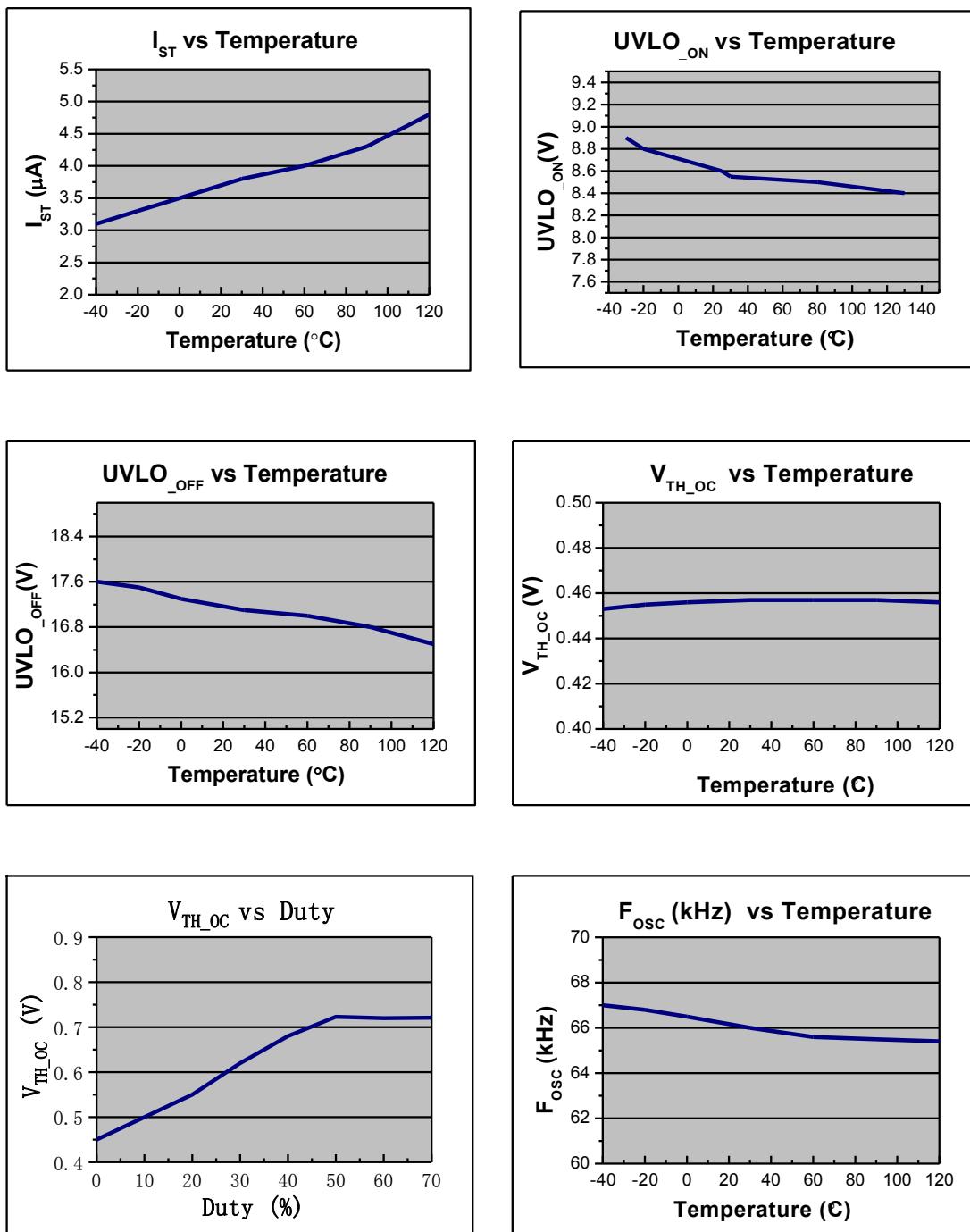
CR5149TJ 提供了丰富的保护功能，比如 cycle-by-cycle 电流限制、UVLO、OTP、VDD_OVP 等。当芯片检测到触发保护关断 GATE，系统处于锁定状态，直到 VDD 下降到 UVLO_{ON} 以下系统才能重新启动。

降低 EMI 技术

CR5149TJ 具有频率抖动功能，即开关频率以 65kHz 为基准频率，在 $\pm 6\%$ 的范围内小幅变化，从而分散了谐波干扰能量。扩展的频谱降低了窄带 EMI，简化了系统的设计。

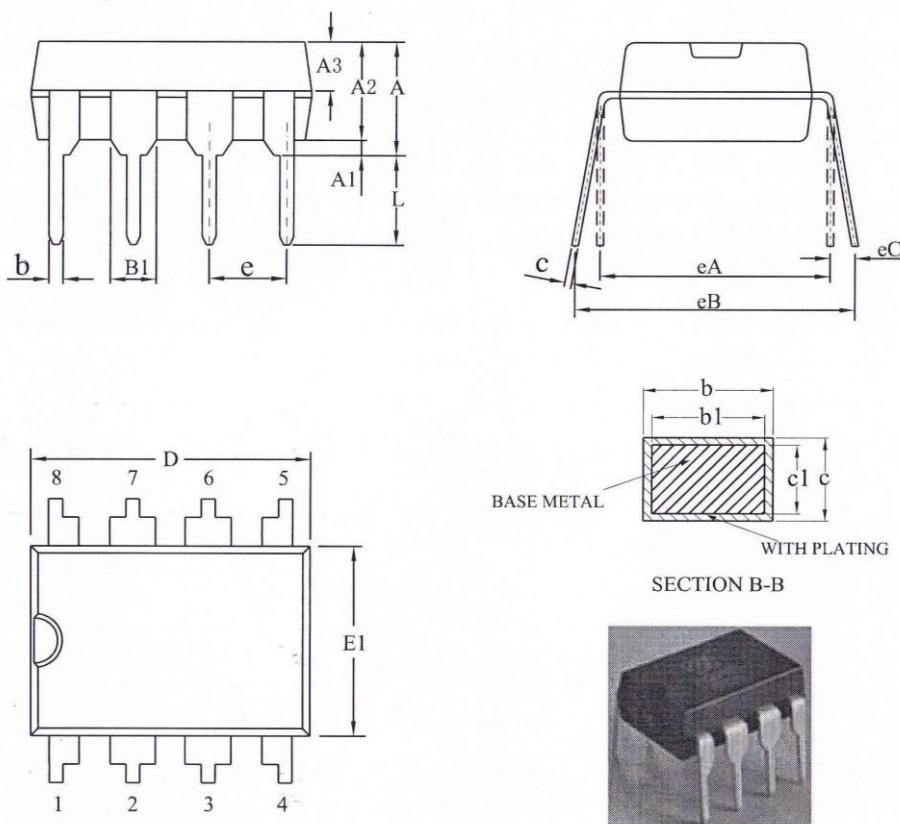
特性曲线

($V_{DD}=18V$, $T_A=25^{\circ}C$ 除了另作说明)。



封装信息

DIP-8L



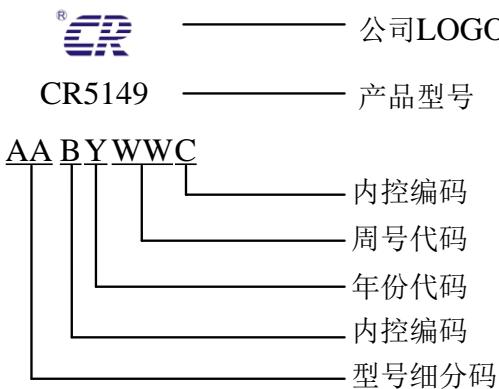
符号	毫米		
	最小	典型	最大
A	3.60	3.80	4.00
A1	0.51	-	-
A2	3.20	3.30	3.40
A3	1.55	1.60	1.65
b	0.44	-	0.52
b1	0.43	0.46	0.49
B1	1.52REF		
c	0.25	-	0.29
c1	0.24	0.25	0.26
D	9.15	9.25	9.35
E1	6.25	6.35	6.45
e	2.54BSC		
eA	7.62REF		
eB	7.62	-	9.30
eC	0	-	0.84
L	3.00	-	-



CR5149TJ

高性能CCM+PFM绿色节能PWM控制开关

印章信息



订购信息

产品型号	封装类型	包装材质	一盒	一箱
CR5149TJ	DIP-8L	料管	2000	20000

产品最小订购量为 20000 片，即一箱的芯片数量。

重要声明

启臣保留对本规格书的修正权，恕不另行通知！客户在下单前应获取产品的最新资料，并验证其是否是完整以及最新版本。

任何半导体产品在特定条件下都有失效或发生故障的可能，买方使用本产品时，应对自己的设计及应用负责，遵守安全标准并采取安全措施，以保护人身及财产安全。